Silicon Standard Recovery Diode

V_{RRM} = 1000 V - 1400 V

I_F = 100 A

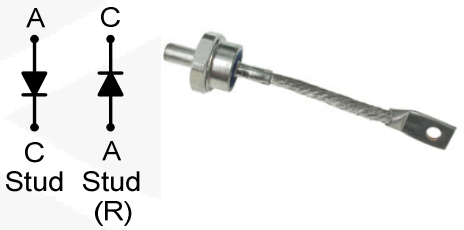
Features

- High Surge Capability
- Types from 1000 V to 1400 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Note:

1. Standard polarity: Stud is cathode.
2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
3. Stud is base.

DO-8 Package



Maximum ratings, at T_j = 25 °C, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	1N3295A(R)	1N3296A(R)	1N3297A(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		1000	1200	1400	V
DC blocking voltage	V_{DC}		1000	1200	1400	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq$ 130 °C	100	100	100	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	T_C = 25 °C, t_p = 8.3 ms	2300	2300	2300	A
I_2t for fusing	I_2t	60 Hz Half wave	22000	22000	22000	A^2sec
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C

Electrical characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	1N3295A(R)	1N3296A(R)	1N3297A(R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	I_F = 100 A, T_j = 130 °C	1.5	1.5	1.5	V
Reverse current	I_R	$V_R = V_{RRM}$, T_j = 130 °C	11	9	7	mA
Thermal characteristics						
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.40	0.40	0.40	°C/W

Electrical Characteristics

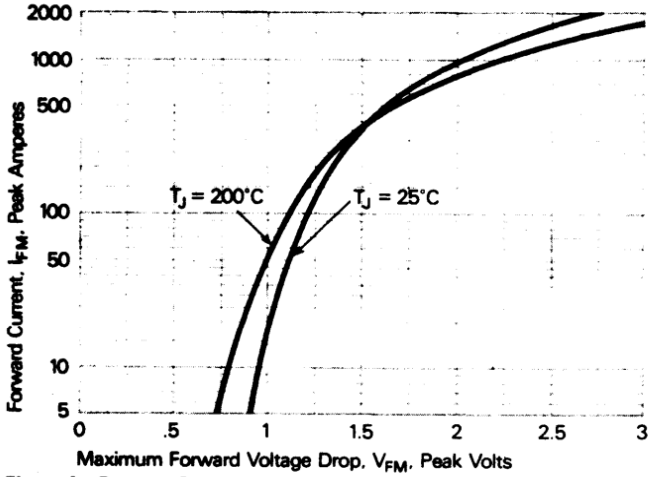


Figure 1. Forward Current vs. Forward Voltage.

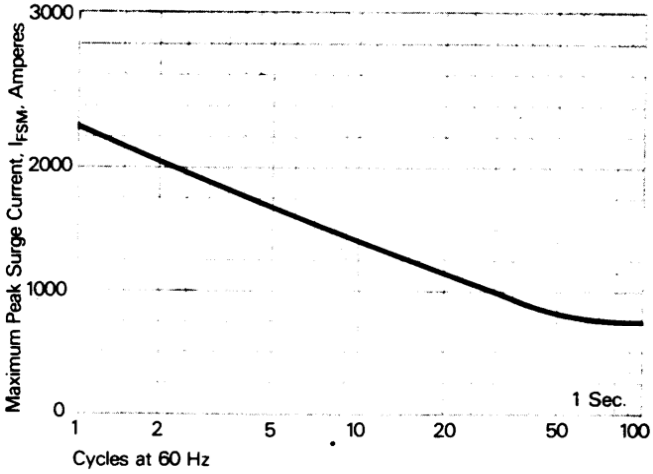


Figure 2. Maximum allowable surge current at rated load conditions.

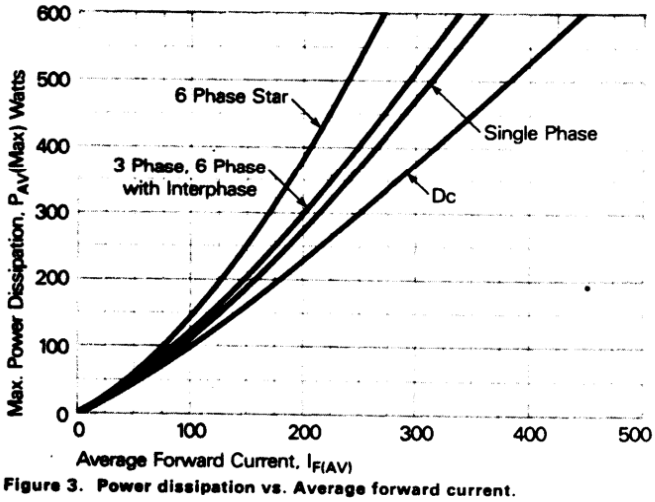


Figure 3. Power dissipation vs. Average forward current.

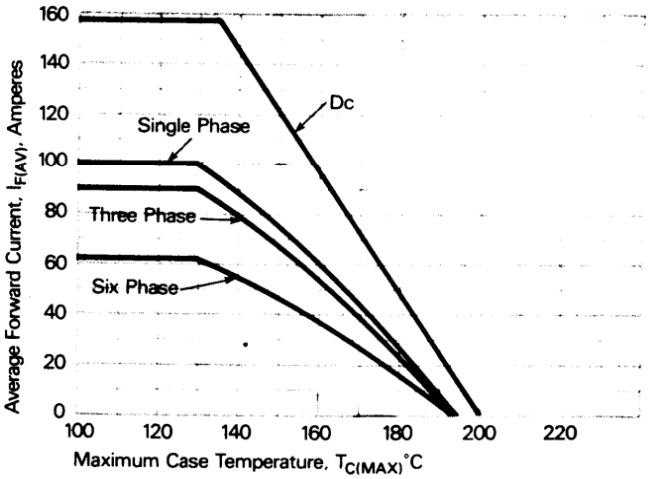
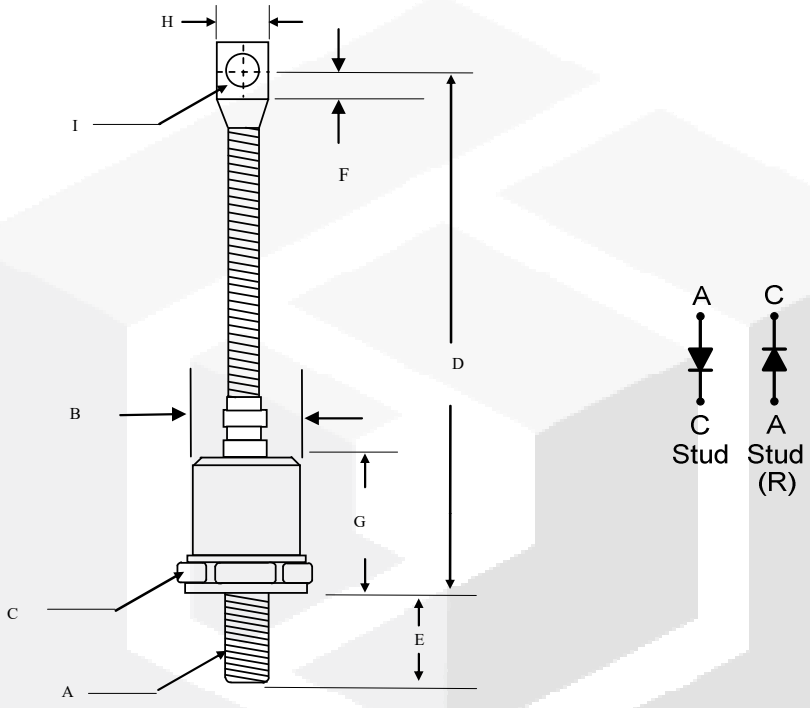


Figure 4. Forward Current vs. Case Temperature.

Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.

DO-8 (DO-205AA)



	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	3/8-24 UNF			
B	-----	φ0.930	-----	φ23.5
C	1.050	1.060	26.67	26.92
D	4.300	4.700	109.22	119.38
E	-----	0.690	-----	17.00
F	0.260	-----	6.50	-----
G	-----	0.940	-----	24.00
H	-----	0.600	-----	15.23
I	0.276	0.286	7.010	7.260

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

GeneSiC Semiconductor:

1N3295A 1N3295AR 1N3296A 1N3296AR 1N3297A 1N3297AR

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9